
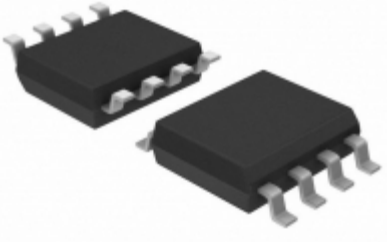
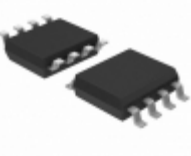
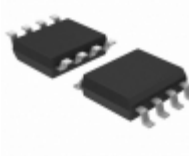

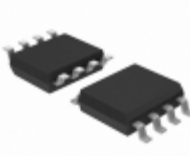

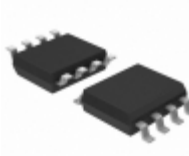
	<h2>SI4176DY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4176DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4176DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4176DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Tc) 2.4W (Ta), 5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4176DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4176DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4176DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4176DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4178DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>	 <p>SI4176DY SI SI4176DY SI</p>	 <p>SI4178DY VISHAY SI4178DY VISHAY</p>	 <p>SI4178DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8SO</p>
 <p>SI4174DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 17A 8-SOIC</p>	 <p>SI4176DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8SO</p>	 <p>SI4178 VISHAY SI4178 VISHAY</p>	 <p>SI4176DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI4162DY-T1-E3	↔ SI4162DY-T1-GE3	⇒ SI4162DY-T1-GE3	D SI4164DY	⇒ SI4164DY-T1-E3
⊖ SI4164DY-T1-GE3	⊕ SI4164DY-T1-GE3	D SI4166DY	⇒ SI4166DY-T1-E3	⇒ SI4166DY-T1-GE3
⊕ SI4166DY-T1-GE3	⊖ SI4168DY	⊕ SI4168DY-T1-E3	↔ SI4168DY-T1-GE3	⇒ SI4168DY-T1-GE3
D SI4170DY-T1-GE3	⊕ SI4170DY-T1-GE3	⊖ SI4172DY	⊕ SI4172DY-T1-E3	⇒ SI4172DY-T1-GE3
⇒ SI4172DY-T1-GE3	↔ SI4174DY	⊕ SI4174DY-T1-E3	⊖ SI4174DY-T1-GE3	⇒ SI4174DY-T1-GE3
↔ SI4176DY-T1-GE3	⇒ SI4178DY	D SI4178DY-T1-E3	⊕ SI4178DY-T1-E3	⊖ SI4178DY-T1-GE3
⊕ SI4178DY-T1-GE3	D SI4186DY-T1-E3	⇒ SI4188DY-T1-E3	↔ SI4190ADY	⇒ SI4196DY-T1-GE3
⊖ SI4196DY-T1-GE3	⊕ SI4200-BM	↔ SI4200-BMR	⇒ SI4200-GM	⇒ SI4200-GMR
⊕ SI4200BM	⊖ SI4200DB-BMR	⊕ SI4200DY-T1-E3	D SI4201-BMR	⇒ SI4201-GMR
↔ SI4202DY	⊕ SI4205-BM	⊖ SI4205-BMR	⊕ SI4206-BM	⇒ SI4206-BMR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited